

半导体硅片清洗用耐强酸高纯Ptfе晶圆盒蚀刻承载器

货号: PL-CP09



简介

专为半导体蚀刻与清洗工艺设计的高端聚四氟乙烯晶圆盒，优异的耐氢氟酸性能与高纯材质，保障关键湿法工艺中硅片的安全承载，适用于洁净室环境下2英寸至12英寸晶圆加工。

了解更多

应用场景	工艺说明	核心优势
氢氟酸蚀刻	将硅片浸入氢氟酸，去除自然氧化层或牺牲层。	完全耐氢氟酸，零材质降解、零污染。
RCA标准清洗	包含SC-1与SC-2的标准化多步清洗工艺，涉及过氧化氢与氢氧化铵。	高纯聚四氟乙烯可避免金属离子重新沉积在晶圆表面。
太阳能电池制造	制绒与磷扩散清洗工序中的硅片承载。	坚固结构可满足工业太阳能制造的高通量生产要求。
化合物半导体	电力电子与射频领域砷化镓、氮化镓、碳化硅晶圆加工。	卡槽设计柔和，可避免损伤高价值脆性基材。
光刻工艺	光刻胶显影与剥离工序中，使用有机溶剂工艺时承载晶圆。	耐溶剂结构，可避免承载器发生溶胀或软化。
CMP后漂洗	化学机械抛光后，对晶圆进行高纯漂洗去除浆料颗粒。	表面光滑，漂洗过程中可彻底去除研磨颗粒。
MEMS制造	深反应离子刻蚀（DRIE）制备流程中，微机电系统晶圆的承载。	卡槽精度高，可保障复杂微结构晶圆的对准精度。
超声清洗	在超声或 megasonic 清洗槽中使用，去除基材表面细小微粒。	材料可有效缓冲振动，同时耐空蚀损伤。

参数	PL-CP09规格详情
型号系列	PL-CP09 (标准款&定制款晶圆盒)
材质	高纯全新聚四氟乙烯 (Polytetrafluoroethylene)
兼容晶圆尺寸	1英寸、2英寸、3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸、5英寸、6英寸、8英寸、12英寸
配置类型	单晶圆承载器、多晶圆盒、定制布局
卡槽容量 (单款)	1-5片 (支持最大12英寸晶圆)
卡槽容量 (多片款)	标准25槽，或定制高密度配置
工作温度	-200°C至+260°C (-328°F至+500°F)
耐化学性	耐受所有常用酸、碱、溶剂 (熔融碱金属除外)
制造工艺	全CNC数控加工 (无注塑成型污染物)
把手选项	单立式把手、双侧把手，或定制机械臂接口
表面粗糙度	Ra < 0.8 μm (可按需提供高抛光面处理)

晶圆尺寸	承载器类型	标准槽数	定制支持
1英寸 / 2英寸	单款/多片款	1、5、10、25	全参数可定制

应用场景	工艺说明	核心优势	
参数	PL-CP09规格详情		
晶圆尺寸	承载器类型	标准槽数	定制支持
3英寸 / 3.5英寸	单款/多片款	1、5、25	全参数可定制
4英寸 / 4.5英寸	多晶圆盒	25	把手与卡槽间距可调整
5英寸 / 6英寸	多晶圆盒	25	把手与卡槽间距可调整
8英寸 / 12英寸	多晶圆盒	13、25	高精度定制